

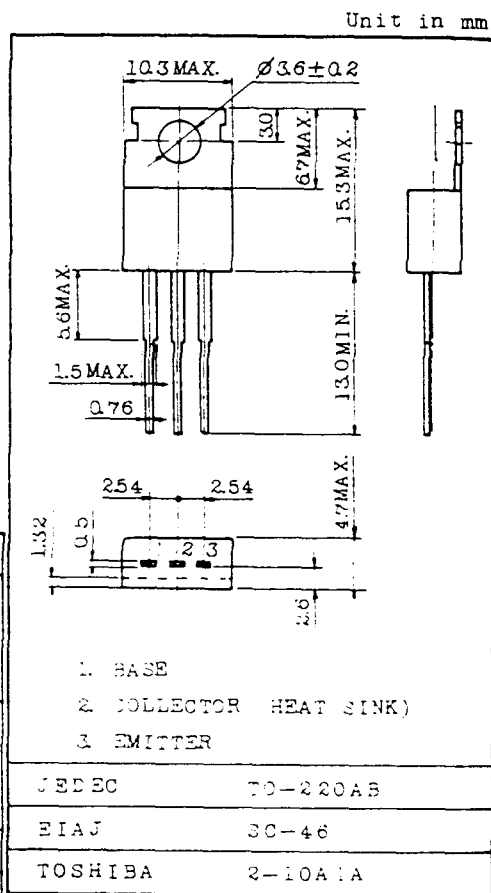
2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 電力増幅用
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.
- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T = 100 \text{ MHz}$ (Typ.)
- ・ 2SA968とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66) の 2SC2239 もあります。
- ・ Complementary to 2SA968.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	V_{CB0}	2SC2238 160	V
		2SC2238A 180	
		2SC2238B 200	
コレクタ・エミッタ 間電圧	V_{CE0}	2SC2238 160	V
		2SC2238A 180	
		2SC2238B 200	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	1.5	A
エミッタ電流	I_E	-1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

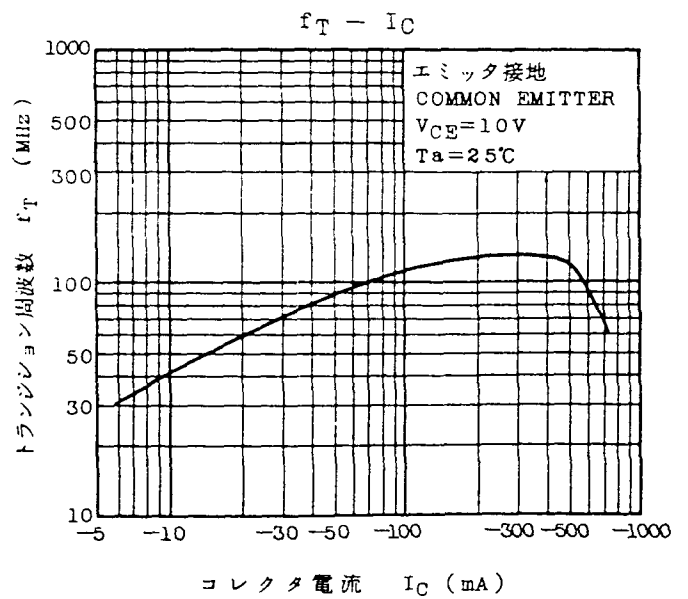
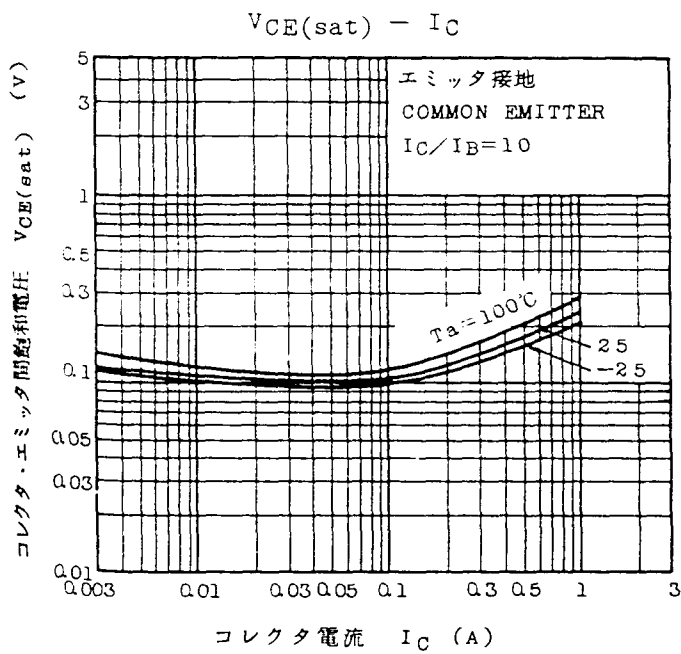
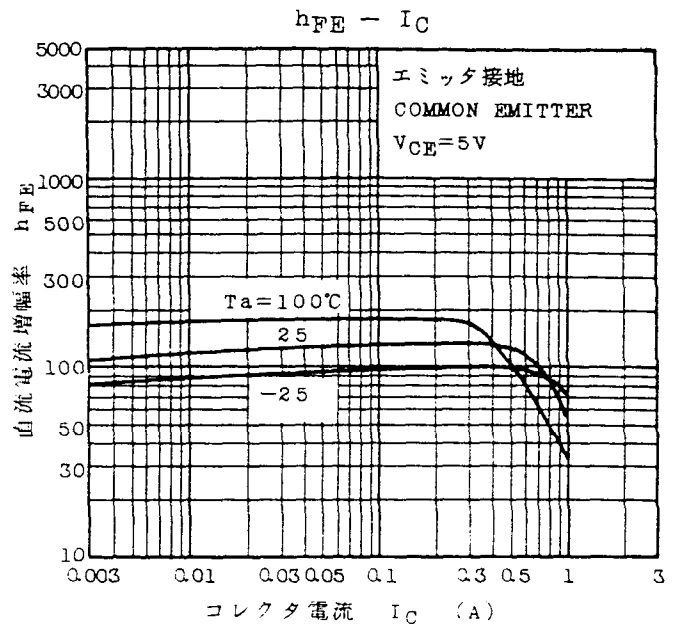
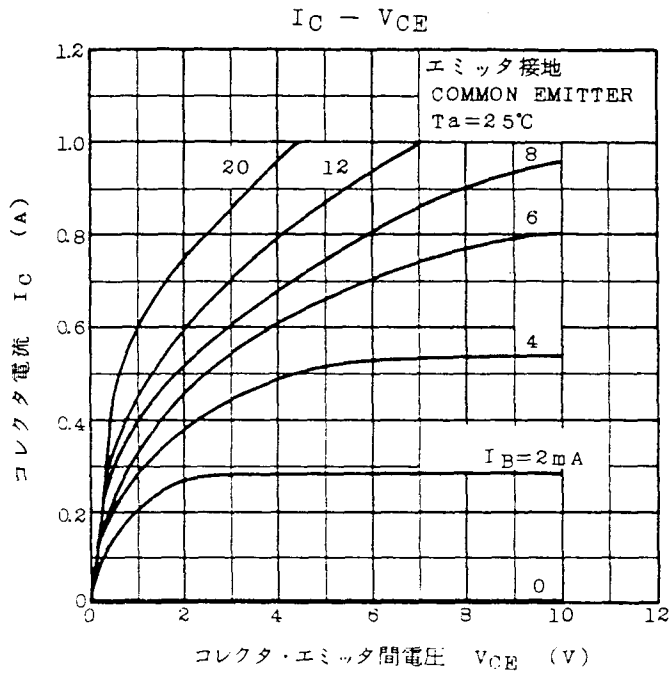


アクセサリは AC75 を適用
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 160 \text{ V}, I_E = 0$	—	—	1.0	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5 \text{ V}, I_C = 0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 0$	160	—	—	V
			180	—	—	
			200	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 1 \text{ mA}, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 100 \text{ mA}$	70	—	240	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$	—	—	1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 500 \text{ mA}$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 100 \text{ mA}$	—	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10 \text{ V}, I_C = 0, f = 1 \text{ MHz}$	—	25	—	pF

2SC2238・2SC2238A 2SC2238B



2SC2238・2SC2238A
2SC2238B

